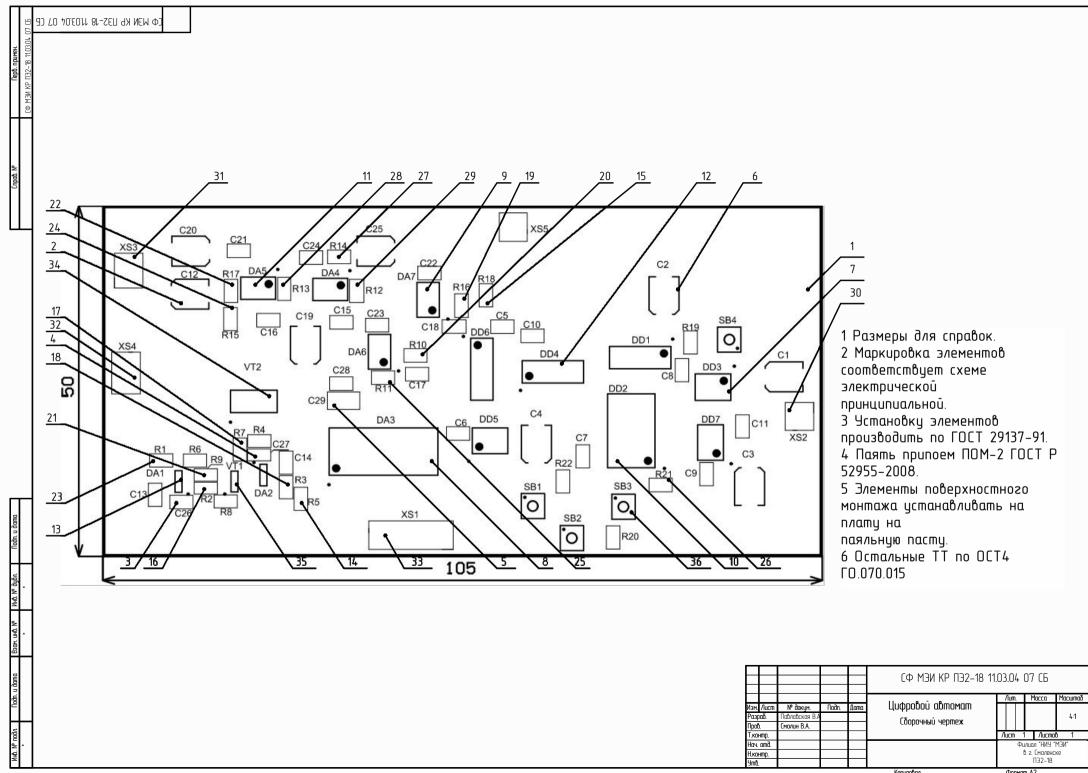
П	формат	Зона	<i>11</i> 03.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Э. примен.					Документация		
Перв.	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 СБ	Сборочный чертеж		
$\parallel$	<i>A4</i>			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 Э1	Схема электрическая структурная		
ab. No	A3			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 Э2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
du)	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 .ЭЗ	, 5		
Ш				СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 .ПЭЗ	принципиальная Перечень элементов		
ДЦ					<u>Детали</u>		
Подп. и дап	A2		1	СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07	Плата печатная	1	
Νο			2		Конденсаторы 0805-X7R-50 B-0,1 мкФ±10%	18	C5C12
9. Nº MHB.	-						[13[18] [21[24] [28]
Взам. инв.			<i>3</i>		0805-X7R-50 B-1000 πΦ±10% 0805-X7R-50 B-2200 πΦ±10%	1	C26 C27
II. и дата			5		1206-X5R-10 B-47 MKΦ±20%	1	<i>C29</i>
подл. Подп.	Pa.	1. /lui 3pað	<u> </u>	№ докум. Подп. Дата Павловская В.А	13N KP 1732-18 11.03	1.04 Nucm	Листов
Инв. № по	При Н.к. Упт	ОНП)		тмолин В.А. ЦИФРОГ	60ū abmomam	7	3

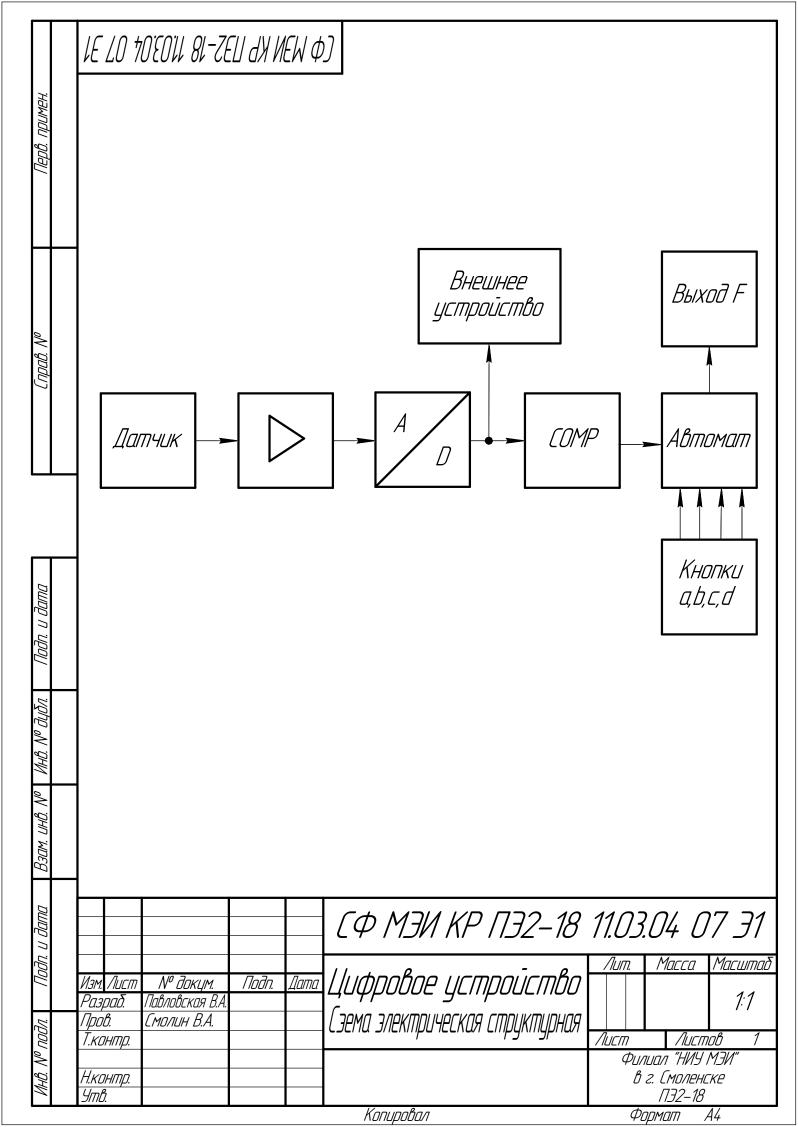
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		6		TECAP-A-50 B-1 mkΦ±10%	8	C1C4,C12
				7EC/11 /1 30 D 1711( + 2 10 / 0		C19,C20
						<i>C25</i>
		_		Микросхемы		222 225
		/		74HC40510 (TSOP-16)	3	<i>DD3,DD5</i>
						<i>DD7</i>
		8		AD7824 (SOIC-24)	1	DA3
		9		AD8561 (SOIC-8)	2	DA6,DA7
		10		CD4044B (SOIC-16)	1	DD2
		11		INA 118E_BB (SOIC-8)	2	DA4,DA5
		12		MC74ACTO8DG (SOIC-14)	3	<i>DD1,DD4</i>
						<i>DD6</i>
		13		OPAX333 (SOT-23)	2	DA1,DA2
				Резисторы		
		14		0805-0.125-4.7 Om ±1%	1	R5
		15		0805-0.125-56 Om ±1%	1	R18
		16		0805-0.125-200 Om ±1%	1	<i>R2</i>
		17		0805-0.125-330 Om ±1%	1	<i>R7</i>
_		18		0805-0.125-470 Om ±1%	1	R3
		19		0805-0.125-1 kOm ±1%	1	R16
		20		0805-0.125-1.5 kOm ±1%	1	R10
$\dashv$	П	21		0805-0.125-2 kOm ±1%	1	R6,R9
		22		0805-0.125-2.2 kOm ±1%	1	R17
		23		0805-0.125-3 кОм ±1%	1	R1
$\dashv$		24		0805-0.125-7.5 kOm ±1%	1	R15
		25		0805-0.125-8.2 kOm ±1%	1	R11
	П	26		0805-0.125-10 kOm ±1%	6	R4,R8
	П	27		0805-0.125-51 k0m ±1%	1	R14
		<u>-</u> 28		0805-0.125-160 k0m ±1%	1	R13
	П	29		0805-0.125-200 KOM ±1%		R12
	oxdot					////
<i>V131</i>	4 /W		№ докум. Подп. Дата	N KP 1732-18 11.03.C	14 [	$J/\sqrt{\frac{n}{2}}$
risi	<i>i.</i> / IUI	-111	ту оокугт үтгөөт. үдата Копиров	Зал Фор	МДП	A4

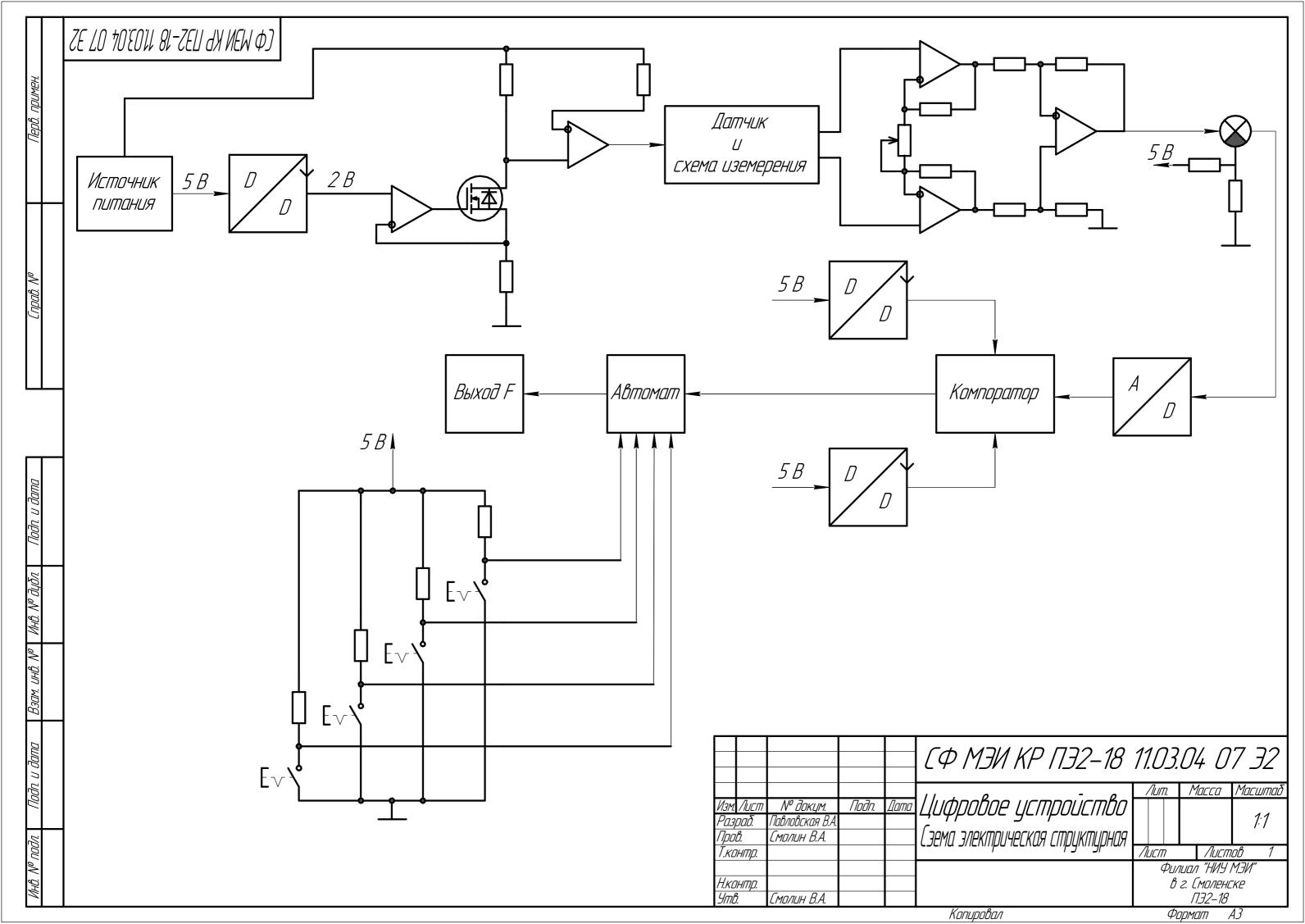
Взам. инв. №

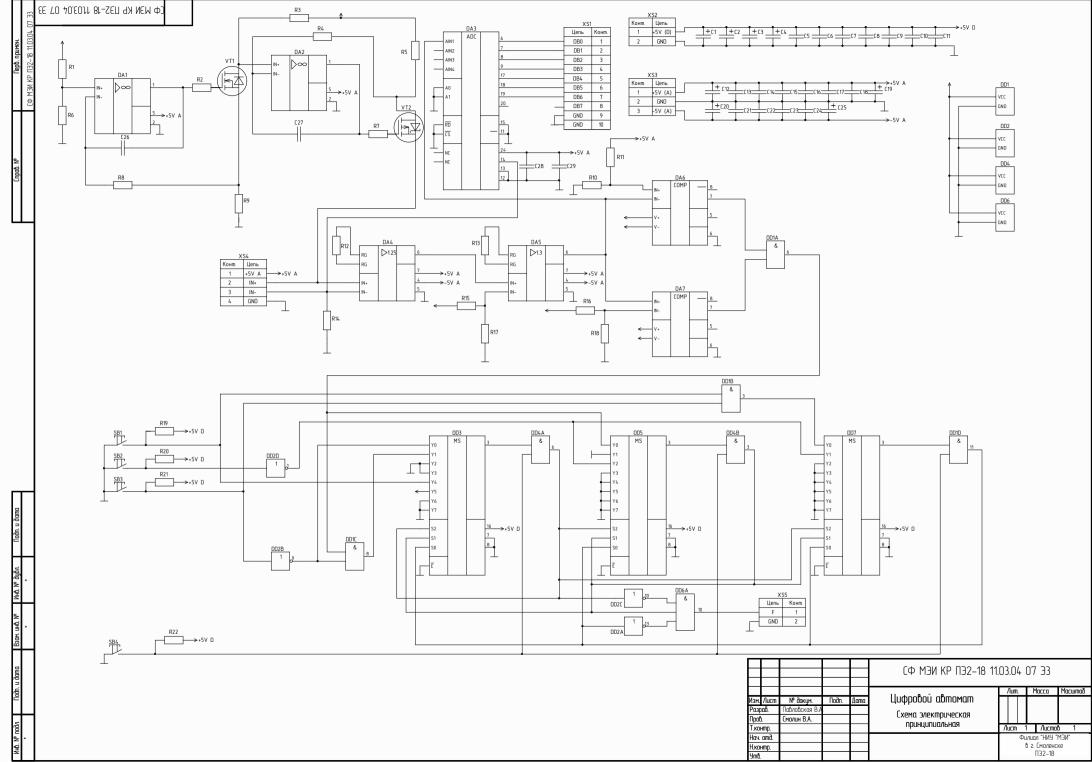
Подп. и дата

Фармат	JUHU []n3	<i>Обозначение</i>	Наименование	Кол.	Приме- чание
			C7		
	+	0	Соединения контактные	2	VCOVC
_	30		C11102M1H	2	XS2,XS
_	3		C11103M1H	1	XS3
_	32		C11104M1H	1	XS4
-	3.	3	C11110M1H	1	XS1
			Транзисторы		
	34	4	NTF2955T1G	1	VT2
	3		SI2304DDS-TI-GE3	1	VT1
_	7.		//cmpo/cmbo woww.mg/wow.	/	CD1 CD
+	30	7	Устройство коммутационное	4	SB1SB
+		+	1T-1187USMD		
$\perp$					
+	+				
+					
+	+				
+					
	7	$\mathcal{L}\phi$	Р МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.0	74 (	07
Изм. /	Nucm	№ докум.   Подп. Цата	Копировал Форг		A4 -



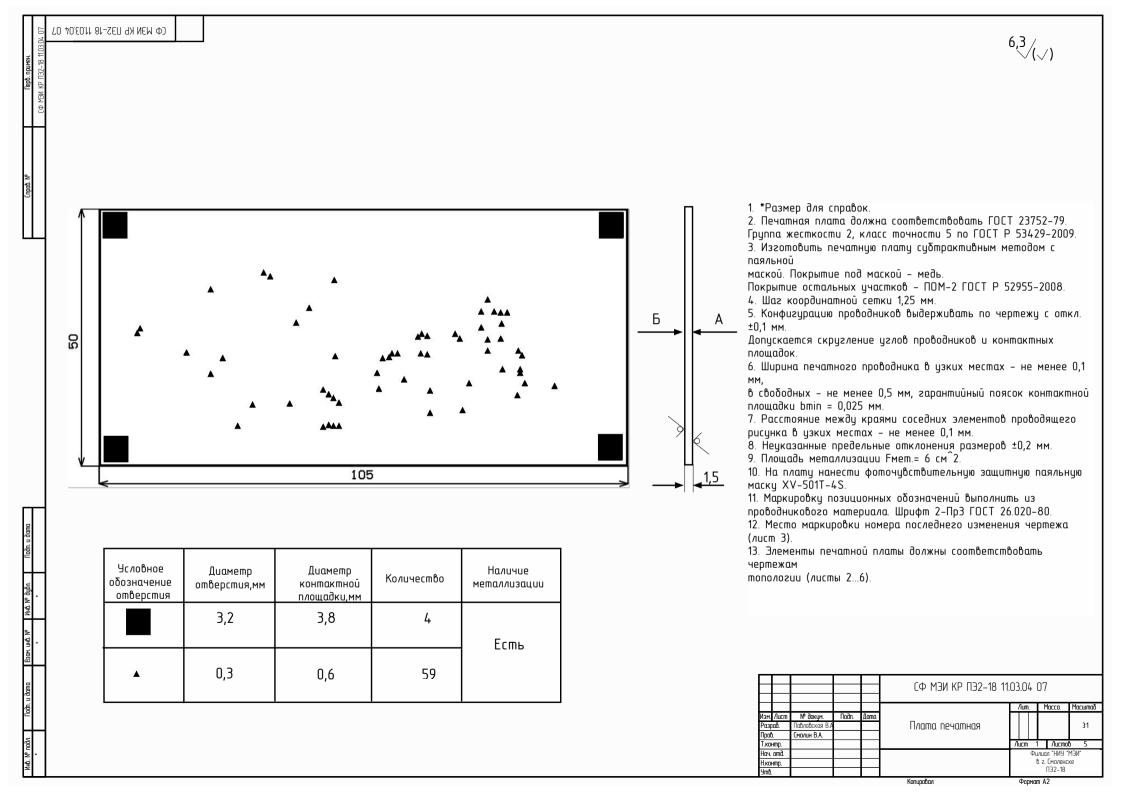






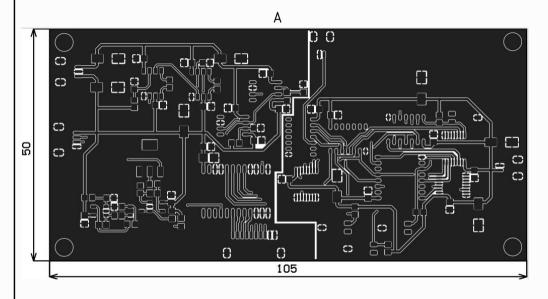
П	Поз. обозна-	Наименование	Кол.	Примечание
Лерв. примен.	<u> 4ehue</u>	Конденсаторы		
	[1[4	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	4	
	<u> </u>		7	
	[12	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	1	
		0805-X7R-50 B-0,1 MKΦ±10%	6	
Ш		TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	2	
	<u>[21[24</u>	0805-X7R-50 B-0,1 mkΦ±10%	4	
	<i>C25</i>	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	1	
οN	<i>C26</i>	0805-X7R-50 B-1000 πΦ±10%	1	
npaß. Nº	<i>C27</i>	0805-X7R-50 B-2200 πΦ±10%	1	
1)	<i>C28</i>	0805-X7R-50 B-0,1 MKΦ±10%	1	
	<i>C29</i>	1206-X5R-10 B-47 ΜκΦ±20%	1	
		Микросхемы		
	DA 1,DA2	OPAX333 (SOT-23)	2	
	_	AD7824 (SOIC-24)	1	
DU		INA 118E_BB (SOIC-8)	2	
и дап.	DA6,DA7	AD8561 (SOIC-8)	2	
Тодп. и	DD1	MC74ACTO8DG (SOIC-14)	1	
	DD2	CD4044B (SOIC-16)	1	
iQVi	<i>DD3</i>	74HC40510 (TSOP-16)	1	
инв. № дубл.	DD4	MC74ACTO8DG (SOIC-14)	1	
MHB.	<i>DD5</i>	74HC40510 (TSOP-16)	1	
o/V	<i>DD6</i>	MC74ACTO8DG (SOIC-14)	1	
UHB. No	<i>DD7</i>	74HC40510 (TSOP-16)	1	
Взам.				
	┥	Резисторы		
: и дата	R1	0805-0.125-3 кОм ±1%	1	
	<i>R2</i>	0805-0.125-200 Om ±1%	1	
Подп.	Изм. Лист	СФ МЭИ КР ПЭ2—18 № докум. Подп. Дата	11.0	03.04 07 17.33
оди:		โดกภกครหกุ BA	,	Лит. Лист Листов 1 2
инв. N <sup>о</sup> подл.	Н.КОНПР.	молин В.А. Цифровой автомал Перечень элементов		Филиал НИУ "МЭИ" В г. Смоленске
*	Утв.	Konupoban		ПЭ2–18 Формат А4

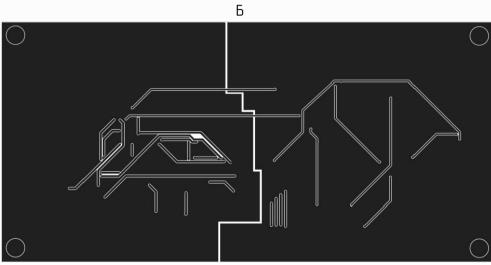
/ 103. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
R3	0805-0.125-470 Om ±1%	1	
R4	0805-0.125-10 kOm ±1%	1	
<i>R5</i>	0805-0.125-4.7 Om ±1%	1	
<i>R6</i>	0805-0.125-2 kOm ±1%	1	
<i>R7</i>	0805-0.125-330 Om ±1%	1	
R8	0805-0.125-10 kOm ±1%	1	
R9	0805-0.125-2 кОм ±1%	1	
R10	0805-0.125-1.5 kOm ±1%	1	
R11	0805-0.125-8.2 kOm ±1%	1	
R12	0805-0.125-200 кОм ±1%	1	
R13	0805-0.125-160 кОм ±1%	1	
R14	0805-0.125-51 kOm ±1%	1	
R15	0805-0.125-7.5 кОм ±1%	1	
R16	0805-0.125-1 кОм ±1%	1	
R17	0805-0.125-2.2 kOm ±1%	1	
R18	0805-0.125-56	1	
R19R22	0805-0.125-10 кОм ±1%	4	
SB1SB4	Устройство коммутационное IT-1187USMD	4	
	Т <i>ранзисторы</i>		
VT1	SI2304DDS-TI-GE3	1	
VT2	NTF2955T1G	1	
	Соединения контактные		
XS1	CI1110M1H	1	
XS2	CI1102M1H	1	
XS3	CI1103M1H	1	
XS4	CI1104M1H	1	
XS5	CI1102M1H	1	
	<u></u>	11.02	$O(\sqrt{O7}/\sqrt{7})^{1/2}$



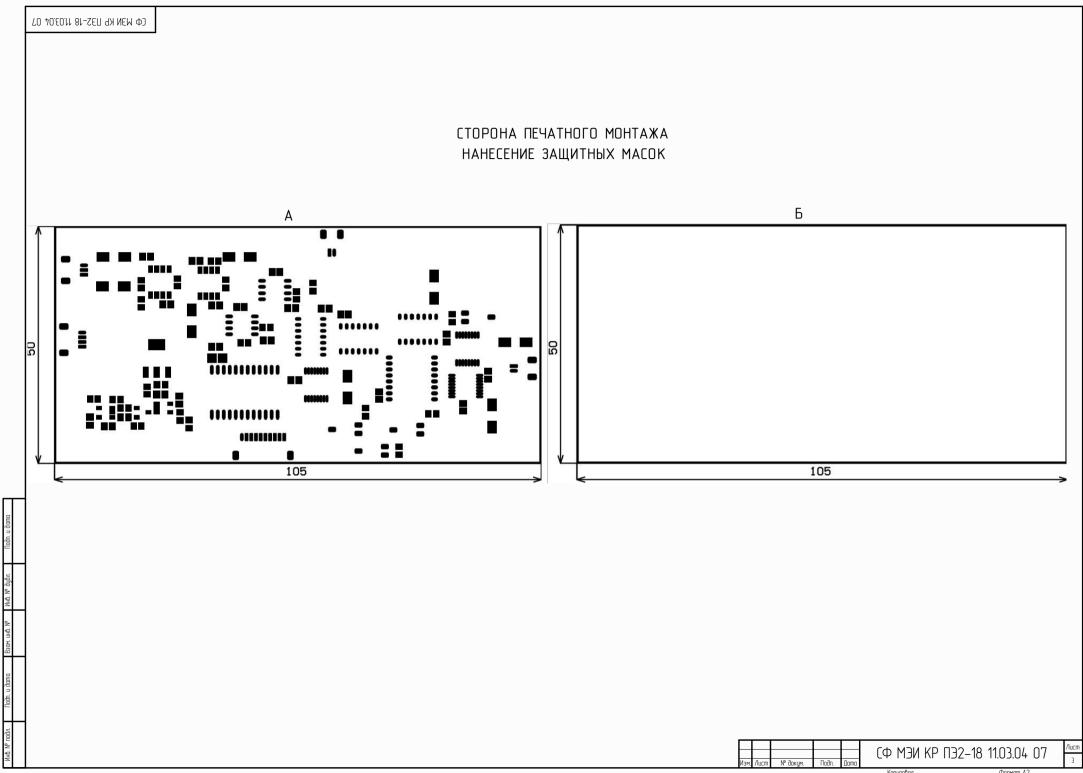
CΦ W3N Kb U35-18 11'03'0¢ 07

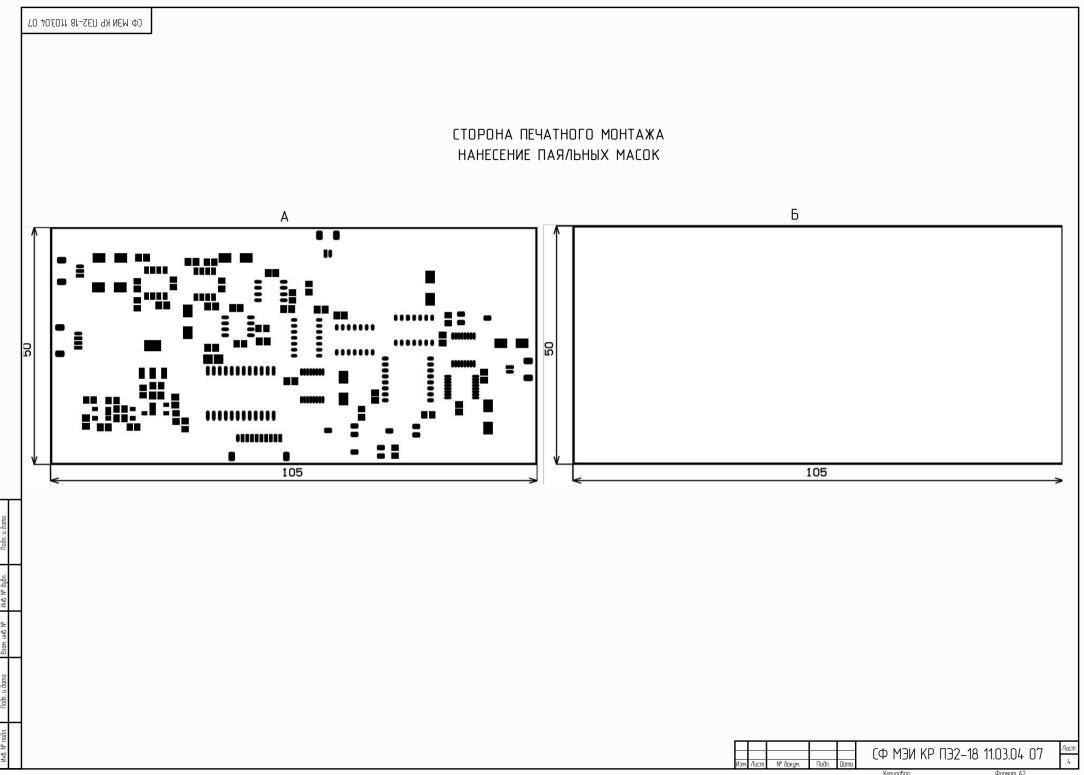
## СТОРОНА ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА





СФ МЭИ КР ПЭ2–18 11.03.04 07

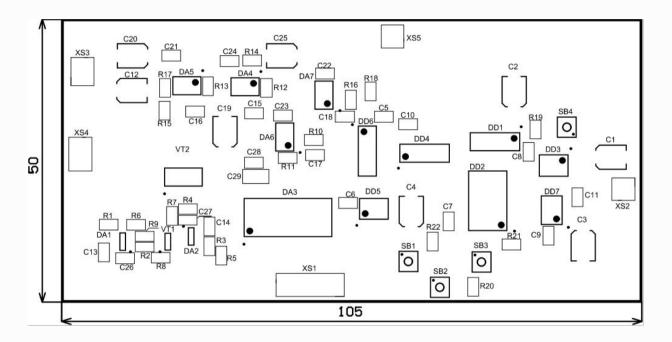




CΦ W3N Kb U35-18 11'03'0¢ 07

## ВЕРХНИЙ СЛОЙ МАРКИРОВКИ

Α



от Лист № доким. Пода. Дата СФ МЭИ КР ПЭ2—18 11.03.04 07